

SSE 200 · SSE 201 · SSE 202



Silizium-npn-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren

Für allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetztechnik.

Bauform 4 SOT23

Wärmewiderstand

R_{thja} Sperrschicht-Umgebung auf Keramik $8 \times 30 \times 0,7 \text{ mm}^3 \leq 0,42 \text{ K/mW}$

Grenzwerte	SSE 200	SSE 201	SSE 202
U_{CBO}	70	100	120 V
U_{CEV} ($-U_{BE} = 1 \text{ V}$)	70	100	120 V
U_{EBO}		5	V
I_C		30	mA
I_B		10	mA
P_{tot} ($\vartheta_a = 85 \text{ °C}$, $R_{thJA} = 0,42 \text{ K/mW}$)		150	mW
ϑ_j		150	°C
ϑ_a		-55 ... +150	°C
ϑ_{stg}		-55 ... +150	°C

Statische Kennwerte

I_{CEV} ($-U_{BE} = 1 \text{ V}$, $U_{CE} = U_{CEV}$)		$\leq 1 \text{ } \mu\text{A}$
I_{EBO} ($U_{EB} = 5 \text{ V}$, $I_C = 0$)		$\leq 100 \text{ nA}$
$U_{(BR)CEV}$ ($I_C = 1 \text{ mA}$, $-U_{BE} = 1 \text{ V}$)	SSE 200	$\geq 70 \text{ V}$
	SSE 201	$\geq 100 \text{ V}$
	SSE 202	$\geq 120 \text{ V}$
U_{CEsat} ($I_C = 15 \text{ mA}$, $I_B = 0,5 \text{ mA}$)		$\leq 0,6 \text{ V}$
h_{FE} ($U_{CE} = 3 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ mA}$)		≥ 32